

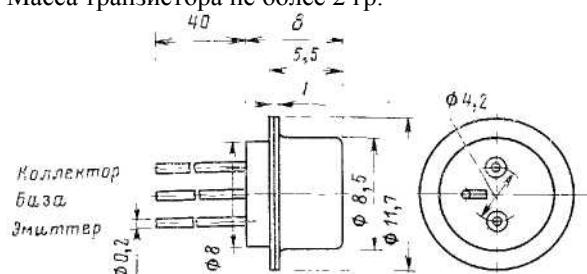
1Т116А, 1Т116Б, 1Т116В, 1Т116Г

Транзисторы германиевые планарные *p-n-p* переключающие маломощные.

Предназначены для работы в формирователях и усилителях импульсов, мультивибраторах и прочих переключающих схемах.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 2 гр.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_{К} = 100$ мА, $t_{и} = 10$ мкс,

$Q > 50$: при $T = 293$ К:

1Т116А, 1Т116Б, 1Т116Г 15-65

1Т116В 20-65

при $T = 213$ К и $T = 343$ К:

1Т116А, 1Т116Б, 1Т116Г 12-80

1Т116В 16-80

Время нарастания при $U_{КБ} = 12,6$ В, $U_{БЭ} = 0,3$ В, $t_{и} = 1,5 \dots 4$ мкс, $f = 30$ кГц:

при $R_{БЭ} = 51$ Ом 1Т116А, 1Т116Б 0,28-0,63 мкс

при $R_{БЭ} = 0, 10, 27$ Ом 1Т116В, 1Т116Г 0,28-0,63 мкс

Время спада при $U_{КБ} = 12,6$ В, $U_{БЭ} = 0,3$ В, $t_{и} = 1,5 \dots 4$ мкс, $f = 30$ кГц:

при $R_{БЭ} = 51$ Ом 1Т116А, 1Т116Б 0,6-2 мкс

при $R_{БЭ} = 0, 10, 27$ Ом 1Т116В, 1Т116Г 0,6-2 мкс

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общей базой при $U_{КБ} = 5$ В, $I_{К} = 1$ мА не менее ..1 МГц

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_{К} = 150$ мА, $I_{Б} = 30$ мА не более 0,25 В

Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = 5$ В, $U_{БЭ} = 0,5$ В не более:

при $T = 293$ К 30 мкА

при $T = 343$ К 200 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} < 550$ Ом 15 В

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} < 550$ Ом, $t_{и} < 5$ мкс 30 В

Импульсное напряжение эмиттер-база при $t_{и} < 5$ мкс 18 В

Импульсный ток коллектора при $t_{и} < 5$ мкс, $Q > 6$:

при $T = 213 \dots 293$ К 300 мА

при $T = 333$ К 250 мА

при $T = 343$ К 15 мА

Постоянный ток коллектора при $T = 293$ К 50 мА

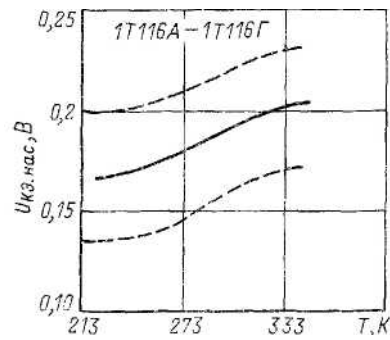
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при $T = 213 \dots 308$ К 150 мВт

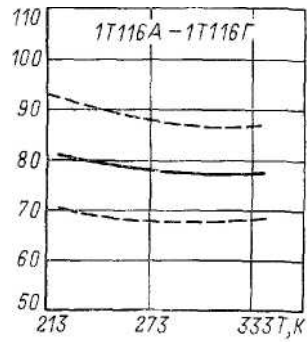
при $T = 343$ К 75 мВт

Температура перехода 358 К

Температура окружающей среды от 213 до 343 К



Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения коллектор-эмиттер от температуры.



Зона возможных положений зависимости входного сопротивления от температуры.